Assorbimento a soglia



Nell'assorbimento a soglia si misura la probabilità di assorbimento di fotoni la cui energia viene fatta variare nell'intorno di una soglia (esempio soglia k del carbonio (C1s))

Si distinguono due regioni di interesse, una in un intorno di 20-30 eV dalla *Ionization Potential* mi dà informazioni sugli stati non occupati del sistema (tecnica NEXAFS). L'altra....

EXAFS – Extended X-ray Absorption Fine Structure

Il fotoelettrone emesso subisce un processo di scattering dagli atomi che sono in prossimità dell'atomo emettitore. Di conseguenza, ci potranno essere, a seconda dell'energia cinetica del fotoelettrone (e quindi a seconda di hv del fotone) delle condizioni di interferenza distruttiva e altre di interferenza costruttiva. Nel primo caso la sezione d'urto di assorbimento sarà minore che nel secondo.

In sostanza, lo stato finale in cui il fotoelettrone viene promosso dipende fortemente dalla disposizione degli atomi circostanti.

Se io misuro la variazione dell'intensità di assorbimento in funzione di hv ho informazioni sulle distanze tra gli atomi del materiale.



17> dipende de lu e dell'interno dell'atomo emettitore

https://www2.ung.si/~arcon/xas/exafs/exafs.htm



Shape resonance: Nel continuo di stati sopra la ionizzazione, ci sono delle energie poco sopra al livello di vuoto in cui è più probabile promuovere l'elettrone. Un modo per descrivere questi stati è di considerare un potenziale aggiuntivo a quello coulombiano, che è il contributo centrifugo che trovo risolvendo l'equazione di Schrodinger. L'elettrone vivrà qui per un tempo molto breve e poi per effetto tunnel uscirà dalla barriera centrifuga e sarà libero.

Posso veolerbe come $V_{eff} = V + \frac{l(l+1)}{2}$

Un'alternativa alla NEXAFS per evidenziare gli stati elettronici non occupati è la tecnica ISEELS (Inner Shell Electron Energy Loss Spectroscopy). Un elettrone di sufficiente energia cinetica può promuovere elettroni di core in stati non occupato o ionizzarli. In generale il processo è complesso e per descriverlo bisogna tener conto della conservazione dell'energia e del momento.



Ovvero il processo è descritto in maniera analoga all'eccitazione con fotoni.

Esemplo ISEELS:

$$E_{R} = 3 \text{ KeV}$$
, $\theta = 0.5^{\circ} = 0$, $\varphi = 2.4 \text{ Å}^{-1}$
 Q eleve now "picule" in modo che $\overline{\varphi} \cdot \overline{r} \ll 1$
 $Nel uno di Q_{15} = 5 \quad r \approx \frac{Q_{0}}{Z}$ \longrightarrow $Q \cdot r \approx 0.32 \dots$ più o mono ci siumo

La tecnica ISEELS ha il vantaggio di essere economica (non mi serve un sincrotrone...) e consente anche di ottenere un ottima risoluzione (0.05 eV). Però è applicabile solo in condizioni di trasmissione, perché devo avere Q piccoli. Va bene quindi per misure gas-phase ma non per film su superfici....



Composizione chimica



https://srdata.nist.gov/xps/Default.aspx

Il processo Auger











All'aumentare di Z diminuisce il tempo di vita della buca 1s che viene creata. Di conseguenza la larghezza in energia dei picchi aumenta.



PHYSICAL REVIEW A

VOLUME 40, NUMBER 11

DECEMBER 1, 1989

K-shell photoabsorption of the N₂ molecule



The peaks between 400 and 402 eV are the N $1s \rightarrow 1\pi_g^*$ excitation and its vibrational sideband. The features observed between 406 and 410 eV are the N $1s \rightarrow$ Rydberg series transitions. The N 1s ionization threshold occurs at 409.938 eV.¹² The area between 413 and 416 eV has been assigned in the literature to double-excitation states that are the shakeups associated with the N $1s \rightarrow 1\pi_g^*$ transition. The broad peak at 420 eV is the σ -shape resonance.

Dicroismo

Nel caso in cui la NEXAFS in una molecola sia misurata su una soglia K, quindi con $|i\rangle = |1s\rangle$, è possibile trovare una ben definita dipendenza della probabilità di assorbimento data dalla regola di Fermi e la geometria dello stato finale.

Innanzitutto, osserviamo che $|f\rangle$ è un orbitale molecolare, si estende in linea di principio su tutta la molecola. Tuttavia, $|i\rangle = |1s\rangle$ è localizzato sull'atomo emettitore. Ne consegue che l'integrale P $\propto |\langle f|\hat{e} \cdot \vec{r}|i\rangle|^2$ coinvolgerà solo la porzione di $|f\rangle$ localizzata dove esiste anche $|i\rangle$. Ai fini del calcolo di P potrò quindi esprimere $|f\rangle$ come combinazione di orbitali atomici dell'atomo emettitore senza perdere in generalità...

Nel caso di atomi del secondo gruppo, posso coinvolgere gli orbitali n=2 per esprimere $|f\rangle$:

$$|f\rangle = a |2s\rangle + b |2px\rangle + c |2py\rangle + d |2pz\rangle$$

Ovvero, dalle coordinate sferiche :

 $|f\rangle = aR_{2s}(r) + R_{2p}(r)(b \sin\vartheta \cos\varphi + c \sin\vartheta \sin\varphi + d \cos\vartheta)$

L' operatore posizione \vec{r} inoltre lo potrò esprimere come $\vec{r} = r(\hat{x}\sin\vartheta\cos\varphi + \hat{y}\sin\vartheta\sin\varphi + \hat{z}\cos\vartheta)$.

Pertanto:

 $\langle f|\hat{e}\cdot\vec{r}|i\rangle = \hat{e}\cdot\langle f|\vec{r}|i\rangle$ e posso scrivere $\langle f|\vec{r}|i\rangle = \int (aR_{2s}(r)+R_{2p}(r)(b\sin\vartheta\cos\varphi+c\sin\vartheta\sin\varphi+d\cos\vartheta))r\begin{pmatrix}\sin\vartheta\cos\varphi\\\sin\vartheta\sin\varphi\\\cos\vartheta\end{pmatrix}(R_{1s}(r))r^{2}\sin\vartheta drd\vartheta d\varphi$

Integrando si ottiene $\langle f | \vec{r} | i \rangle = R \frac{4\pi}{3} (b\hat{x} + c\hat{y} + d\hat{z}) \operatorname{con} R = \int R_{2p}(r) (R_{1s}(r)) r^3 dr$

 $\langle f | \vec{r} | i \rangle$ è un vettore che ha la stessa direzione dell'orbitale dello stato finale. Se definisco questo vettore $\vec{O} = b\hat{x} + c\hat{y} + d\hat{z}$, la probabilità di assorbimento P sarà $P \propto |\hat{e} \cdot \vec{O}|^2 = cos^2 \delta$, con δ angolo compreso tra la direzione che mi descrive l'orbitale e il campo elettrico.



Ad esempio, nel caso della molecola di azoto, se cponsidero le transizioni sul LUMO, \vec{O} sarà un vettore perpendicolare all'asse della molecola.









In generale, se l'interazione con il substrato aumenta,le componenti NEXAFS si allargano. Questo principalmente è dovuto alla diminuzione del tempo di vita degli stati eccitati.

.

Dicroismo



(ASO two-fob) to superfice (110)
I d
$$(as^2 \theta Ga^2 d + Sin^2 \theta Sin^2 d Ga^2 \phi$$

S objection \vec{E} in mode the $(as \phi = 1)$
 $d (as^2 \theta Ga^2 d + Sin^2 \theta Sin^2 d$
 $-D St (\theta = 45^{\circ}) \rightarrow (intensitie oliverite
indipendente de d
Maggic on ple$

(ASO three-fold)
$$\rightarrow$$
 (111) FCC
 $I \ll \cos^2 \Theta (\cos^2 \alpha + \frac{1}{2} \sin^2 \Theta \sin^2 \alpha - \frac{non}{2} \text{ dipende de $\phi} (non so determine P'orientazione et motion to de oble motion)$
 $Se = \frac{\Theta - e^{1} \cos(\sqrt{\epsilon}) = 54.7^{\circ}}{1} = 0$ (3 fold o $n - \text{fold} = 33$
 $Scompone la dipendenze de α !!$$

L-Cysteine adsorption on Au(110)

Simple aminoacid Thiolate bond with substrates



Au(110) surface

- anisotropy in the molecular self assembly process.
- Chirality effects







FIG. 3 (color). Most stable cysteine double-row structure, as abtained from the DET calculations, superimposed onto an

Kühnle et al. PRL 93 (2004) 86101

N1s: zwitterionic vs acidic population



NH₂ 399.5 eV NH₃⁺ 401.5 eV

- Total acidic population established at $\theta < 0.4$ ML
- majority of zwitterions for $\theta > 0.2 \text{ML}$

C1s NEXAFS: molecular orientation from polarization dependance



Variable polarization NEXAFS: azimuthal orientation



Approccio building blocks nell'interpretazione degli spettri





J. Phys. Chem. C 2018, 122, 28692-28701







PHYSICAL REVIEW B 79, 115446 (2009)

Filling empty states in a CuPc single layer on the Au(110) surface via electron injection















On-surface synthesis of larger molecules





Anchoring platforms?



Naphtylmethylamine, NMA



Is boroxine on Au(111) still a Lewis acid?

Anchoring platforms?



Next step:



Gli step negli spettri NEXAFS : IP step





2=3. IS - C-H*, Ryolberg 7 (= (& resonance

$$\overline{I}_{stop} = H\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{11} \text{ eten} \left(\frac{E-P}{P/2}\right)\right) \qquad \text{allegeometric Loventrians}$$

$$H \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{12} \text{ erf} \left(\frac{E-P}{P_c}\right)\right) \qquad \text{erf}(r) = \frac{2}{Fr} \int_{0}^{r} e^{-r} dr$$

$$\overline{I}_{step pervises} = H\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \text{ erf} \left(\frac{E-P}{P_c}\right)\right) \qquad \text{erf}(r) = \frac{2}{Fr} \int_{0}^{r} e^{-r} dr$$

• Gli step negli spettri NEXAFS : Fermi step

Se una molecola è a contatto con la superficie di un metallo, posso avere degli obitali non occupati ibridi molecola metallo, ad un energia che va dal livello di Fermi in su. Diventa possibile che l'elettrone 1s venga eccitato su uno di questi orbitali. Dal punto di vista della molecola è come se venisse ionizzata ad un potenziale inferiore a quello di ionizzazione. Sperimentalmente registro uno step di intesità all'energia corrispondente al livello di Fermi.

Fermi step





Allineamento XPS-NEXAFS





Physical Review B 67, 235420 (2003)



Physical Review B 67, 235420 (2003)